⑩ 日本国特許庁(JP)

① 特許出願公開

[®]公開特許公報(A) 平3-127816

®Int. C1.5

織別配号

庁内整理番号

匈公開 平成3年(1991)5月30日

21/027 H 01 L GIIB 7/125 7/14

8947-5D Α

8947-5D 7013-5F 7013-5F

H 01 L 21/30

3 4 1

審査請求 未請求 請求項の数 1 (全6頁)

マルチ電子源 60発明の名称

②特 算 平1-267575

22出 平1(1989)10月13日 頭

個発 塚 明 者 本 者

朙

健 夫 東京都大田区下丸子3丁目30番2号 キヤノン株式会社内

個発 辺

男 僧

東京都大田区下丸子3丁目30番2号 キヤノン株式会社内 キヤノン株式会社内

渡 @発 明 者 奥 昌 彦

東京都大田区下丸子3丁目30番2号 東京都大田区下丸子3丁目30番2号

砂出 願 人 キヤノン株式会社

砂代 理 人 弁理士 福森 久夫

日月 末田 40

1. 発明の名称

マルチ電子数

2.特許請求の範囲

それぞれ電子ビームを放出する多数の電子概を 縦列および横列のマトリクス状に基板上に配置 し、射出された電子ピームを被照射体に照射すべ く各前記電子版を順次駆動するようにして成るマ ルチ電子圏において、前記級列に沿う前記電子棚 の配列方向と前記機列に沿う前記電子振の配列方 向とを直交させないように設定したことを特徴と するマルチ電子源。

3. 発明の詳細な説明

[産業上の利用分野]

本発明は、例えばレジスト指面用装置、電子 ピーム記録用装置等のように、例えばショット キー型半導体電子源から放出する電子ピームを用 いて微細かつ高密度の電子ピーム照射を行なう べく使用されるマルチ電子機に関するものであ

【從来技術】

従来、この種のマルチ電子棚としては、例えば 米国特許第4259678号明和書、米国時許 4303930号明細書に記載されているような ものが知られている。これによると、マルチ電子 塚は、多数の電子器が縦列および横列のマトリク ス状に基板上に配置され、各前記電子源を順次一 方向に駆動するようにして成り、各電子源の機の 配列方向(×方向)と数の配列方向(y方向)と のなす角度が直交したいわゆる単純マトリクスで 配置した構成となっている。

[発明が解決しようとする課題]

しかしながら、上記従来技術の構成では、×方 向とy方向とのなす角度が直交しているので、例 えば被照射体たる移動物体に向けて各電子振から 電子ピームを放出する場合、電子ピームを移動物 体上で連続的に照射させるようにしようとする と、各電子源は固定されていることから、移動物 体の移動距離に応じて各電子類を一個すっ個別に 創御(いわゆる点類次駆動制御)しなければなら

ない。 換言すれば、従来技術の構成は、 制御用に 読み込ませるデータが多岐になること、 電子ピー ムの放出制御が複雑であること、 電子ピームの放 出のタイミング的余裕度が極めて制約される等の 問題があり実用性に乏しいものである。

本発明は、簡単な改良を加えることにより、特に移動物体に対する電子ビームの照射を容易に行なえるようにしたマルチ電子源を提供すること目的とする。

『題観を解決するための手段』

上記目的を達成すべく本発明は、それぞれ電子ピームを放出する多数の電子源を提列および横列のマトリクス状に基板上に配置し、放出された電子ピームを被照射体に照射すべく各前記電子源を取次駆動するようにして成るマルチ電子源において、前記級列に沿う前記電子源の配列方向とを直交させないように設定したことを特徴とする。

基板上に配置されたマトリクス状電子源の横列

3

は、配練用の階段状に形成された板状電極 4 が各イオン注入領域 2 と交叉するように、すなわち級方向 (各 y 方向 a、 b、 c、 d ····) に形成されている。したがって、各 y 方向 a、 b、 c、 d ····における各高濃度イオン注入領域 3 を結ぶ線と各 x 方向 A、 B、 C、 D ····における各高濃度イオン注入領域 3 を結ぶ線とのなす角度は直交していない(X 方向に沿う線(X - X 牌)と Y ' - Y' 線とのなす角度 θ は B C 度よりも小である)。

さらに、前記イオン往入領域2上には、前記高 議度イオン注入領域3から放出された電子を上方 に案内するべく脚状の電極5を介して平屋根状の 電極6が形成されている。

各前記イオン注入領域2の境部の表面部にはそれぞれ高級民拡散層7が形成され、各高級良拡散層7が形成され、各高級良拡散層7上にはオーミックコンタクト部8上には電板8だれ、各オーミックコンタクト部8上には電板8がそれぞれ投続されている。また、各前記板状電板での機部にはそれぞれ電板11が接続されている。

方向と級列方向とが直交しないので、各電子部から移動物体上に連続的に電子ピームを照射する場合、移動物体が一つの電子部とこれに開接する原子部との間を移動する時間内に、一の列の全部のマトリクス電子派を次々と駆動(線原次駆動)させるという単純な制御で行なえる。

[実施例]

従って、マトリクス状に配列された各電子振は、各×方向A、B、C、D…の所定の電極9と各ッ方向a、b、c、d…の所定の電極10との間に逆パイアス電圧を印加すると、該両電極の交点位置にある電子振である高浪度イオン往入領域3がON状態となってアパランシェ増幅が生じ、当該高浪度イオン注入領域3からスポット状の電子が放出される。

なお、本実施例では電子源としてショットキー型半導体電子源を用いているが、特にショットキー型半導体電子源である必要はなく、PN接合、NEA(負の電子親和力)等の各種の半導体電子源を用いることが出来る。

次に、本実施例により電子ビームを移動物体に限射し、連続的なビーム照射領域を形成するための手順につき述べる。

まず、電子ビームが照射されるべき領域をマトリクス電子側に対向した位置に置く。この場合、例えば×方向Aの電板2と各y方向 a。 b . c . d ... の電板4との交点位置の電子振をON 状態に

するかのFF状態にするかは予め何らかの方法で 決められており、電板2と各y方向 a. b. c. d … の電極 4 との間への逆パイアス電圧印加によ り、 x 方向 A の各電子源から順次電子放出が生じ る。

次に同様な方法で他のX方向B, C, D…の電極2と各y方向B, b, c, d…の電極4との間への逆パイアス電圧印加によりそれぞれ線原次駆動する。

全部のマトリクス位置の電子器を駆動し終えた 後に、一の電子線とこれに競接する他の電子線と の間の距離だけ移動物体を従前の移動方向と する方向に90度の方向に移動させ、再び各 X X が 向 A 。 B 。 C 。 D ··· と各 y 方向 a 。 b 。 c 。 d ··· と との交点位置の電子線を順次級動する。 かかる電子線を 手が駆動を繰り返すことにより、移動物体の被照 射面を電子ピームにより会面照射することができる。

第4図は、マルチ電子源を電子ビームメモリに 適用した場合を示している。12は上記第1の実

. **7**

第 5 図は、マルチ電子標を電子ビーム指題装置 に適用した場合を示している。同図において、マ ルチ半導体電子源1 2 は上記第 1 の実施例で述べ たと同様な構成のものである。 1 9 は半導体ウェ ハーであり、 2 0 はレジスト上に描かれた電子 ビーム照射領域である。

前記マルチ電子振12の駆動手順は上記第2実施例とほぼ同様であるが、鉄電子振12の駆動劇

施例で述べたと同様な構成のマルチ半導体電子 源、13はフェトダイオード、14は光を実空客 熱へ入れるための導入部、15は光信号を送るた めのファイバー、15は高圧電源、17は電子源 を認動させるための電源、18は電子線記録媒体 である。該記録媒体18としては31のMOS線 造、アモルファス状の310g線違、A2gの 腹および51N膜等の多層顕構造のものがある。

上記のように様成されているので、マルチ電子 源12の駆動用の制御信号は、搬送クロックと問時に多貫させ光信号として光ファイバー15を介して伝達され、フォトダイオード13で再び電気信号に戻される。マルチ電子標12は高圧電源16が接続されることにより高電圧になっているが、制御信号は光媒介としており、電気的に絶縁されているので耐ノイズ性に優れている。

マルチ電子 版12の光制製信号は、フォトダイ オード13で電気信号に変換され電気制制信号と しての復調制御信号となる。該制制信号はマルチ

8

初はウェハー19のステージ移動に応じ、括回すべき全エリアにおいて電子振12を順次減駆動を 行う。

[発明の効果]

さらに、マルチ電子派をマトリクス状に構成して原次線駆動するため、移動体に同一の電子ピームの照射領域を形成しようとする場合、電子源が 一次元配列である場合に比べて、移動体の移動速 度を低下することができ、致電子ビームの照射領域が楕円変形するのを小さくすることができる。 また、電子ビームの照射領域を連続かつ高密度で 形成できるので、電子線メモリ、技調装置の他、 電子はブリンター等の広範囲の応用が可能となる。

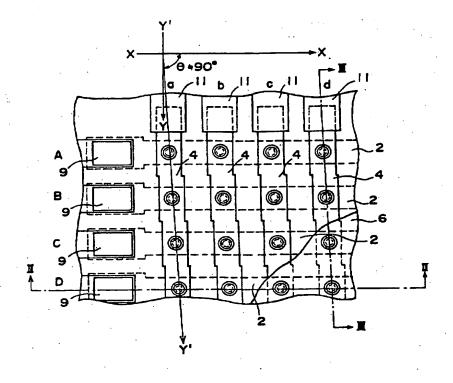
4. 図面の簡単な説明

第1回乃至第3回は本発明の一実施例を示すものであり、第1回はマルチ電子源の平面図、第2図は第1図のⅡ一Ⅱ線に沿う断面図、第3回は第1回のⅢ一Ⅲ線に沿う断面図、第4回は電子ピームメモリ装置への応用例を示す平面図、第5図は電子ピーム揺躍装置への応用例を示す平面図であま

1 … 基板、 3 … P型高級度イオン往入領域(電子駅)、 1 0 … ショットキー電極(電子駅)、 1 2 … マルチ電子機。

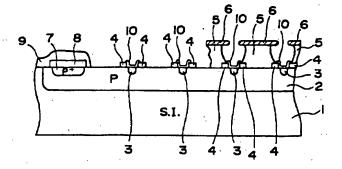
1 1

第 | 図

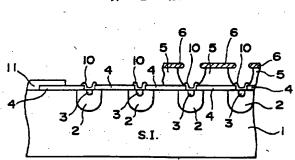


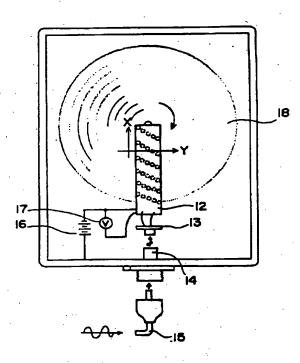
第 2 図



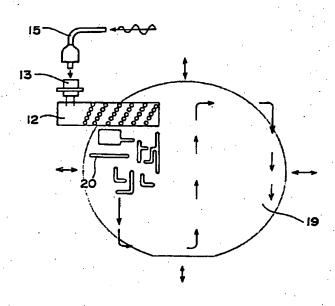


第3図





第 5 図



平成2年 2月 6日

特許庁長官

- 1. 事件の表示 平成元年特許顧第267575号
 - 2. 発明の名称 マルチ電子源
 - 3. 補正をする者

事件との関係 特許出職人

住 所 東京都大田区下丸子3丁目30番2号

名 称(100)キャノン株式会社

代表者 山 路 敬 三

4. 代 理 人 〒180 電話03(358)8840 住 所 東京都新宿区本塩町 1 2

四谷ニューマンション107

氏 名 (8809) 弁理士 福森久夫

氏 名 (8809) 弁様工 福祉2 5. 補正命令の日付(発送日)

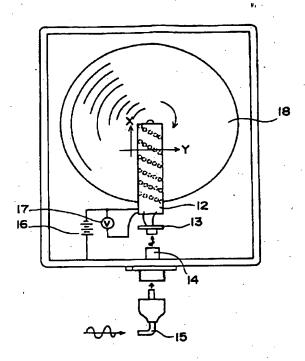
平成2年 1月30日

6. 補正の対象

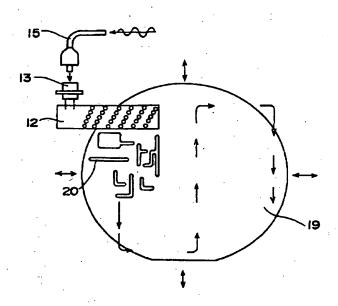
図面 (第4.5図)

7. 補正の内容 別紙の通り





第 5 図



PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

03-127816

(43) Date of publication of application: 30.05.1991

(51)Int.CI.

H01L 21/027 G11B 7/125 7/14 G11B

(21)Application number: 01-267575

(71)Applicant: CANON INC

(22)Date of filing:

13.10.1989

(72)Inventor: TSUKAMOTO TAKEO

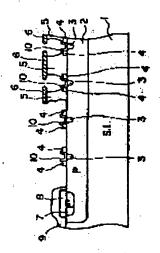
WATANABE NOBUO

OKUNUKI MASAHIKO

(54) MULTIPLE ELECTRON SOURCE

(57)Abstract:

PURPOSE: To easily irradiate a moving article with an electron beam through a simple improvement by so setting an arraying direction of electron sources disposed along a longitudinal row as not to cross the arraying direction of electron sources disposed along a lateral row. CONSTITUTION: The arraying direction of electron sources 3 disposed along a longitudinal row is so set as not to cross the arraying direction of electron sources 10 disposed along a lateral row. Thus, since the lateral and longitudinal directions of the matrixlike sources 3, 10 disposed on a board 1 are not perpendicularly crossed, if a moving article is continuously radiated with an electron beam from the sources 3, 10, the entire sources 3, 10 of one row can be sequentially driven (linearly and sequentially drive) under a pure control within time moving the article between the source 3 and the adjacent source 10. Thus, continuous electron beam irradiation region is formed by simple means, and signal setting for control is simplified, and further a control circuit is simplified due to the simplification.



LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of

rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998,2003 Japan Patent Office